



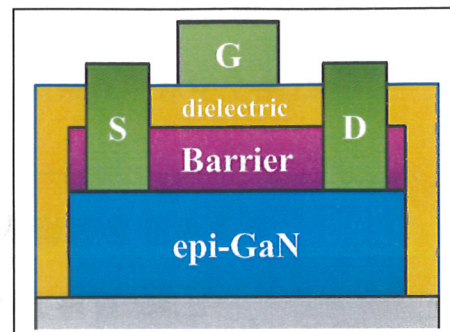
二維電子氣高電子遷移率電晶體

提案人：陳敏璋 教授

單位：國立臺灣大學 材料系

簡歷：

http://www.mse.ntu.edu.tw/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=47&Itemid=902&lang=tw



市場及需求：

二維電子氣(2DEG)高電子遷移率電晶體(HEMT)

技術摘要(含成果)：

使用特殊技術將具有高結晶度的薄膜沉積在 GaN 上，有明顯二維電子氣(2DEG)的產生，對高電子遷移率電晶體(HEMT)有相當大的幫助。

優勢：

此技術擁有高均勻度，並且可以在低溫下沉積薄膜。

競爭產品：

MOSFET, HEMT

專利現況：

無

專利現況：

- (1)本技術已有相關專利（中華民國專利申請號:XXXX；美國專利證號:XXX）。
- (2)本研究團隊具有數十年研究經驗…
- (3)其他…

聯絡方式(請不用填)：

臺大產學合作總中心

Tel: 02-3366-9945, E-mail: ntuciac@ntu.edu.tw



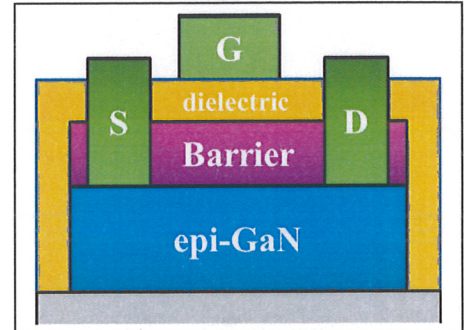
High electron mobility transistors

PI : Prof. Miin-Jang Chen
Department of Materials Science and Engineering,
National Taiwan U.

Experience:

http://www.mse.ntu.edu.tw/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=47&Itemid=902&lang=tw

Market Needs: High electron mobility transistors



Our Technology:

The barrier layer grown on the GaN epilayer is well crystallized and exhibits significant 2DEG characteristics.

Strength:

The growth of the uniform barrier layer can be carried out at a low temperature.

Competing Products:

MOSFET, HEMT

Contact (do not need to fill out):

Center for Industry-Academia Cooperation, NTU
Tel: 02-3366-9945, E-mail: ntuciac@ntu.edu.tw

This information herein is intended for potential license of NTU technology only. Other usage of all or portion of this information in whatever form or means is strictly prohibited. Kindly contact us and we will help to achieve your goal the best we can.